第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会



硬X線光電子分光法における データベースの開発 一施設間連携による取り組みー

公益財団法人 高輝度光科学研究センター(JASRI) 安野 聡

あいちシンクロトロン光センター:池野 成裕、上原 康、渡辺 義夫 名古屋大学シンクロトロン光研究センター:陰地 宏 高輝度光科学研究センター:廣沢 一郎









2019. 3. 5

JASRI



光ビームプラットフォーム

JASRI 2019. 3. 5

光ビームプラットフォーム

活動方針

①放射光の高度利用の推進

複数施設を活用した高度な課題解決のコーディネーションとその技術蓄 積施設間のデータ較正と標準スペクトルDB構築による標準化を推進

② 地域発課題の展開

地域発の課題をプラットフォームに展開して高度支援することで課題を解 決フィードバックや他地域への波及を通して地域の活性化にも貢献

③人材育成

2019.3.5

レーザーと放射光の融合領域をカバーする次世代を担う人材を育成大学の豊富な人材を活用して新技術の普及に取組むエキスパートを養成

- •硬X線 XAFS Gr.
- •硬X線光電子分光(HAXPES)Gr.
- ▪軟X線XAFS Gr.
- •小角散乱 Gr.



各サブグループによりラウンドロビン 実験、データベース開発、標準化など の取り組みを実施

光ビームプラットフォーム

施設連携、地域発課題の展開

連携を活かし、複数の施設の活用による課題解決を推進 事例蓄積を通してソリューションのノウハウや技術を高度化



第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会

2019.3.5

放射光施設 AichiSR & SPring-8











愛知県瀬戸市 2013年 供用開始 周長:72 m 電子エネルギー:1.2 GeV 兵庫県佐用町 播磨科学公園都市 1997年 供用開始 周長:1436 m 電子エネルギー:8 GeV

物質・材料科学、生命科学、宇宙・惑星科学、考古学、科学鑑定など幅広い分野で利用されている

IASRI



硬X線光電子分光法(HAXPES)の特徴



第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会

7



第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会

2019.3.5

HAXPESのメリット(1):検出深度が深い



2019. 3. 5

JASRI

第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会

HAXPESの
 HAXPESのメリット(1):検出深度が深い



JASRI

2019.3.5

10

HAXPESの大リット(2): 測定可能なピークが多い

ラボXPS

- 1.5 keV以下ではピークが密集
 →他のピークと重畳しやすい
- s軌道以外はピーク分裂で解析困難

HAXPES

- 共存元素の内殻やオージェ、プラズ モンロス等のピークの重畳を回避し やすい
- ピーク分裂がなく解析が容易な深い 1s準位が使える(Al 1s: 1.65 keV, Si 1s: 1.84 keV)

								_
Element		1s	2s	2p1/2	2p3/2	3s	3p1/2	3p3/2
1 H	н	14						
2 H	le	25						
3 L	_i	55						
4 B	le	112						
5 E	8	188						
6 (284	07					
	N O	410	37					
	5	043 607	42					
9 r 10 N	۲ ام	870	10	22	22			
10 N	la	1071		31	31			
12 M	1a	1303	89	50	50			
13 A	4J	1560	118	73	73			
14 5	Si	1839	150	100	99			
15 F	P	2146	189	136	135			
16 5	s	2472	231	164	163			
17 C		2822	270	202	200			
18 A	٩r	3206	326	251	248	29	16	16
19 H	ĸ	3608	379	297	295	35	18	18
20 C	a	4039	438	350	346	44	25	25
21 S	6c	4492	498	404	399	51	28	28
22 T	Гі	4966	561	460	454	59	33	33
23 N	v	5465	627	520	512	66	37	37
24 C	Cr	5989	696	584	574	74	42	42
25 M	In	6539	769	650	639	82	47	47
26 F	е	7112	845	720	707	91	53	53
27 C	:0	7709	925	793	778	101	59	60
28 N	Ni	8333	1009	870	853	111	68	66
29 C	u.	8979	1097	952	933	123	11	75
30 Z	n	9659	1196	1045	1022	140	91	89
31 G	a	10367	1299	1143	1116	160	104	100
32 G	e le	1103	1415	1240	1217	100	120	1/1
33 A	15	1007	1027	1359	1324	205	140	141
34 3 35 B	2r	12000	1792	1474	1434	250	107	192
36 K	51 (r	1/326	102	1731	1678	207	222	21/
37 R	2h	15200	2065	1864	1804	327	249	239
38 5	Sr	16105	2216	2007	1940	359	280	270
39	Y	17038	2373	2156	2080	392	311	299
40 Z	Źr	17998	2532	2307	2223	430	344	330
41 N	lb	18986	2698	2465	2371	467	376	361
42 M	10	20000	2866	2625	2520	506	412	394
43 T	Ċ	21044	3043	2793	2677	544	448	418
44 R	lu	22117	3224	2967	2838	586	484	461
45 R	۲h	23220	3412	3146	3004	628	521	497
46 P	d	24350	3604	3330	3173	672	560	532

JASRI

HAXPESの特徴 HAXPESのメリット(2): 測定可能なピークが多い



K. Kobayashi, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 547 (2005) 98

Spin-orbit splitting によるピークの分裂がない準位を選択することで, 解析が比較的容易になる場合がある。



JASRI

2019.3.5



HAXPESの課題と目標

JASRI 2019. 3. 5

HAXPESの課題

HAXPESのさらなる普及、利用促進のためには実用的な分析技術の確立が必要 →イメージしやすいのはラボのXPS



2019.3.5

HAXPESの課題

- ・基礎的なデータが少ない(特に深い準位)
- ・定量のためのデータが無い(相対感度係数)
- ・光電子の検出深さ(有効減衰長さ)
- ・チャージアップ対策
- ・エネルギー軸の較正(確認)方法
- ・リコイル効果

2019.3.5

- ・強度のリニアリティ
- •透過関数 ~ E_{kin}-1







- 2016年~実施中
- チャージアップ対策、サンプリング方法

2nd step:分析深さ(光電子の有効減衰長さ)

TPP-2Mで推測(実測値との比較はしておきたい) 2019年度より開始予定

3rd step:スペクトルデータベース

データ開示方法の検討 データ形式、メタデータの検討





日本発の長く使ってもらえる標準的なデータベースを目指す

第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会

研究開発ツールとして定着化

放射光ユーザーの拡大

JASRI I

2019.3.5





HAXPES装置

SPECS PHOIBOS (Aichi SR BL6N1)



Scienta R4000-10keV (SPring-8 BL46XU)



hv (3.0 keV) with Si double crystal monochromator
Horizontal/vertical focusing mirror
Analyzer: PHOIBOS 150CCD
Slit size: 7 mm × 25 mm curved
Temperature: RT
Pass energy: 20 eV
Incident angle: 55°
Take off angle : 90°

JASRI

2019.3.5

 hv (5.9, 7.9, 9.9 keV) with Si double crystal and Si channel cut monochromator
 Applyzery P4000, 10koV(

- •Analyzer: R4000-10keV
- •Slit size: 0.5 mm × 25 mm curved
- •Temperature: RT
- Pass energy: 200 eV
- Incident angle : 10°
- •Take off angle : 80°



・フッ化物

ラボXPSでは S_{F1s} =1として、フッ化物による実測データが使用されている。





			X-ra	ys.			
Line	Element	Compound	Mg	Al	Line	Element	Compound
1s	Li	LIF	0.023	0.0225			
			0.017	0.019 ⁶		(K ₂ NbF ₇
	Be	BeF2		0.040 ^e			KSbF ₆
	в	NaBF₄	0.103 ^m	0.14 ⁵			K ₂ TaF ₇
		KBF₄	(K) ^d 0.136 ¹⁴				
	С	(CF ₂) ₀	0.24	0.24 ⁵			
				0.248		100	
	N	(NH₄)₃AIFe	0.40		2p _{3/2}	Ca	CaF ₂
		(NH ₄) ₃ InF ₆		0.42			
		KNO ₃	0.50	0.49			CaCO ₃
_ (¥		KSCN	0.4314			Sc	

Table 2. Data base for strong line consitivity factors

C.D.Wagner et at., Surf. Interface Anal. 3, 211 (1981)

チャージアップは問題ないが、表面が酸化され、 感度係数算出の元となる組成が不明瞭

・酸化物

様々な元素で酸化物が存在し、

扱いや入手が比較的容易

チャージアップは対策の検討の必要はある。



2019. 3. 5

JASRI



取り組み結果 チャージアップ対策

JASRI 2019. 3. 5

チャージアップ対策

入手しやすいのは酸化物粉末状試料 ⇒チャージアップが起こりやすい





・グラファイト粉末 (~200 µm)/カーボンテープ ・カーボンブラック (~ 50 nm)/カーボンテープ ・コロイダルグラファイト (水溶性)/アルミ箔









カーボンブラック、コロイダルグラファイト、 カーボンナノチューブ保持材で効果を確認。

JASRI

2019.3.5

⇒基本的にはカーボンブラックを使用

チャージアップ対策



カーボンブラックや中和処理(電子+イオン)により、ピーク値やピーク形状が改善

JASRI



取り組み結果 相対感度係数

JASRI 2019. 3. 5

相対感度係数





硬X線領域における相対感度係数が整備されていないため、 HAXPESでは組成の定量評価が実施できないていない。 (但し、イオン化断面積の計算値はいろいろある)

定量分析を行うためには

実測値を使用する。
計算値を使用する。
都度標準試料を測定する。

まずは実測値を求めて計算値と比較



相対感度係数

化合物を使用した相対感度係数 (よく使用されているのは $S_{F1s} = 1$)

Number of photoelectrons

I = n	$\Delta \Omega$	$(d\sigma / d\Omega)\lambda$,	1
$\frac{n_a}{n_b} =$	$\frac{I_a / T_a D_a A}{I_b / T_b D_b A}$	$\frac{\mathbf{A}_{a}\left(d\sigma/d\Omega\right)_{a}\lambda_{a}}{\mathbf{A}_{b}\left(d\sigma/d\Omega\right)_{b}\lambda_{b}},$	
227	S = TD	$A (d\sigma / d\Omega) \lambda,$]
感閁	E係数		
$\frac{n_a}{n_b} =$	Ia / Sa Ib / Sb	$\frac{I_a}{I_b} = \frac{n aS a}{n bS b}$	

I:光電子強度(数/sec)
n:原子密度(atoms/cm³)
F:X線光子のフラックス数(光子数/m² sec)
dσ/dΩ:微分光イオン化断面積(m²)
A:光電子が発生する試料上の面積(m²)
T:透過関数
D:検出効率
λ:平均自由行程(m)
Element a, b

 $\frac{S_a}{S_b} = \frac{T_a D_a A_a (d\sigma / d\Omega)_a \lambda_a}{T_b D_b A_b (d\sigma / d\Omega)_b \lambda_b},$

相対感度係数(S_a/S_b)は1つの物 質中の異なる2つの元素(元素a, b) の光電子強度(I_a, I_b)の比から定義で きる.

Compound A Compound B



<u>2つの元素の強度比は物質に大きく</u> 依存しない。

光電子の運動エネルギーの選択範囲の広い(...λ の範囲も広い)HAXPESで使用しやすい (そもそもλ の異なるピークで定量する事に意味があるのか?という問題はありますが)

JASRI



Measurements for Standard samples for RSFs





酸化物の準備が困難な元素は、 LiF, SiC, GaN, AlF₃, NaCl, GaP, ZnS, KCl, GaAs, ZnSe, InSbなどを使用





計算值

Differential photoionization cross section for linearly polarized photons

$$d\sigma / d\Omega = \frac{\sigma}{4\pi} \left[\left(1 + \frac{\beta}{2} \left(3\cos^2 \theta - 1 \right) + \left(\delta + \gamma \cos^2 \theta \right) \sin \theta \cos \varphi \right) \right],$$



•TDA(Spectrometer function) varies with E^{-1} • λ calculated by IMFP TPP-2M

References

-J. H. Scofield, Theoretical Photoionization Cross Sections from 1 to 1500 KeV Lawrence Livermore Lab. Rept. 1973, UCRL-51326.

•M. B. Trzhaskovskaya, V. I. Nefedov and V. G. Yarzhemsky, Atomic Data and Nuclear Data Tables 77, 97-159 (2001)

•S.Tanuma et al, Surf. Interf. Anal., 43, 689 (2012)

相対感度係数





計算値のλの見積りがずれている?



2019.3.5



AichiSR BL6N1 (3 keV)、SPring-8 BL46XU (6, 8, 10 keV) 実験値と計算値の比較

Empirical sensitivity factors Theoretical sensitivity factors 100 100 Empirical and Theoetical sensitivity factors, Empirical 8 keV Empirical and Theoetical sensitivity factors, Theoretical 8 keV Sn Empirical 3 keV Theoretical 3 keV Empirical 6 keV Theoretical 6 keV 10 10 Empirical 10 keV Theoretical 10 keV relative to 0 1s relative to 0 1s 0.1 0.1 2p_{3/2} 2p_{3/2}-0.01 0.01 10 100 1000 10 100 1000 Binding Energy (eV) Binding Energy (eV)

X線エネルギーに依存した実験値と計算値の傾向は概ね一致している。

■ JASR 2019. 3. 5



各準位毎の実験値と計算値の傾向はばらばら。 X線エネルギーと準位から相対感度係数を求めるための計算方法や指標が必要か? ■ JASRI

2019.3.5

まとめ



・HAXPESは深部を非破壊で分析できる有用な手法であるが、基礎 データの不足など実用化に向け多くの課題がある。

・光ビームプラットフォーム HAXPES Gr.では相対感度係数や有効減 衰長さを中心としたデータベース開発を開始した。

・相対感度係数は実測値と計算値に一定の相関性が認められる。
 一方でエネルギー可変の放射光の特徴を活かすためには
 X線エネルギーと準位から相対感度係数を算出できるような計算方法を確立する必要がある。

JASRI

2019.3.5